# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-modules

# FP100R12KT4

EconoPIM™3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled4 Diode
EconoPIM™3 module with trench/fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled4 diode

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter

### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage | $T_{vj}$ = 25°C | $V_{CES}$ | 1200 | | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current | $T_C$ = 95°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C | $I_{C\,nom}$ | 100 | | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_P$ = 1 ms | $I_{CRM}$ | 200 | | A |
| Gesamt-Verlustleistung<br>Total power dissipation | $T_C$ = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C | $P_{tot}$ | 515 | | W |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage | | $V_{GES}$ | +/-20 | | V |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage | $I_C$ = 100 A, $V_{GE}$ = 15 V<br>$I_C$ = 100 A, $V_{GE}$ = 15 V<br>$I_C$ = 100 A, $V_{GE}$ = 15 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $V_{CE\,sat}$ | | 1,75<br>2,05<br>2,10 | 2,20 | V<br>V<br>V |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage | $I_C$ = 3,80 mA, $V_{CE}$ = $V_{GE}$, $T_{vj}$ = 25°C | | $V_{GEth}$ | 5,2 | 5,8 | 6,4 | V |
| Gateladung<br>Gate charge | $V_{GE}$ = -15 V ... +15 V | | $Q_G$ | | 0,80 | | µC |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor | $T_{vj}$ = 25°C | | $R_{Gint}$ | | 7,5 | | Ω |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance | f = 1 MHz, $T_{vj}$ = 25°C, $V_{CE}$ = 25 V, $V_{GE}$ = 0 V | | $C_{ies}$ | | 6,30 | | nF |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance | f = 1 MHz, $T_{vj}$ = 25°C, $V_{CE}$ = 25 V, $V_{GE}$ = 0 V | | $C_{res}$ | | 0,27 | | nF |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current | $V_{CE}$ = 1200 V, $V_{GE}$ = 0 V, $T_{vj}$ = 25°C | | $I_{CES}$ | | | 1,0 | mA |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current | $V_{CE}$ = 0 V, $V_{GE}$ = 20 V, $T_{vj}$ = 25°C | | $I_{GES}$ | | | 100 | nA |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Gon}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_{d\,on}$ | | 0,16<br>0,17<br>0,17 | | µs<br>µs<br>µs |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Gon}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_r$ | | 0,03<br>0,04<br>0,04 | | µs<br>µs<br>µs |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Goff}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_{d\,off}$ | | 0,33<br>0,43<br>0,45 | | µs<br>µs<br>µs |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Goff}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_f$ | | 0,08<br>0,15<br>0,17 | | µs<br>µs<br>µs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V, $L_S$ = 40 nH<br>$V_{GE}$ = ±15 V, di/dt = 3000 A/µs ($T_{vj}$ = 150°C)<br>$R_{Gon}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{on}$ | | 5,50<br>8,50<br>9,50 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse | $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V, $L_S$ = 40 nH<br>$V_{GE}$ = ±15 V, du/dt = 3600 V/µs ($T_{vj}$ = 150°C)<br>$R_{Goff}$ = 1,6 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{off}$ | | 5,50<br>8,50<br>9,50 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data | $V_{GE}$ ≤ 15 V, $V_{CC}$ = 900 V<br>$V_{CEmax}$ = $V_{CES}$ -$L_{sCE}$ ·di/dt | $t_P$ ≤ 10 µs, $T_{vj}$ = 150°C | $I_{SC}$ | | 400 | | A |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case | pro IGBT / per IGBT | | $R_{thJC}$ | | | 0,29 | K/W |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | | $R_{thCH}$ | | 0,13 | | K/W |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\,op}$ | -40 | | 150 | °C |

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj}$ = 25°C | $V_{RRM}$ | 1200 | V |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current | | $I_F$ | 100 | A |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current | $t_P$ = 1 ms | $I_{FRM}$ | 200 | A |
| Grenzlastintegral<br>I²t - value | $V_R$ = 0 V, $t_P$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 125°C<br>$V_R$ = 0 V, $t_P$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 150°C | I²t | 1550<br>1500 | A²s<br>A²s |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage | $I_F$ = 100 A, $V_{GE}$ = 0 V<br>$I_F$ = 100 A, $V_{GE}$ = 0 V<br>$I_F$ = 100 A, $V_{GE}$ = 0 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $V_F$ | | 1,70<br>1,65<br>1,65 | 2,15 | V<br>V<br>V |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current | $I_F$ = 100 A, - $di_F/dt$ = 3000 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = -15 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $I_{RM}$ | | 115<br>125<br>130 | | A<br>A<br>A |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge | $I_F$ = 100 A, - $di_F/dt$ = 3000 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = -15 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $Q_r$ | | 9,50<br>17,5<br>20,5 | | µC<br>µC<br>µC |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy | $I_F$ = 100 A, - $di_F/dt$ = 3000 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = -15 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{rec}$ | | 3,50<br>6,00<br>7,50 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | $R_{thJC}$ | | | 0,50 | K/W |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | | $R_{thCH}$ | | 0,225 | | K/W |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\,op}$ | -40 | | 150 | °C |

## Diode, Gleichrichter / Diode, Rectifier

### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj}$ = 25°C | $V_{RRM}$ | 1600 | V |
| Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip<br>Maximum RMS forward current per chip | $T_C$ = 80°C | $I_{FRMSM}$ | 100 | A |
| Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom<br>Maximum RMS current at rectifier output | $T_C$ = 80°C | $I_{RMSM}$ | 150 | A |
| Stoßstrom Grenzwert<br>Surge forward current | $t_p$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 25°C<br>$t_p$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 150°C | $I_{FSM}$ | 1150<br>880 | A<br>A |
| Grenzlastintegral<br>I²t - value | $t_p$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 25°C<br>$t_p$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 150°C | I²t | 6600<br>3850 | A²s<br>A²s |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage | $T_{vj}$ = 150°C, $I_F$ = 100 A | | $V_F$ | | 1,00 | | V |
| Sperrstrom<br>Reverse current | $T_{vj}$ = 150°C, $V_R$ = 1600 V | | $I_R$ | | 1,00 | | mA |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | $R_{thJC}$ | | | 0,40 | K/W |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | | $R_{thCH}$ | | 0,18 | | K/W |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\,op}$ | -40 | | 150 | °C |



| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper

### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage | $T_{vj}$ = 25°C | $V_{CES}$ | 1200 | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current | $T_C$ = 95°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C | $I_{C\,nom}$ | 50 | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_P$ = 1 ms | $I_{CRM}$ | 100 | A |
| Gesamt-Verlustleistung<br>Total power dissipation | $T_C$ = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 175°C | $P_{tot}$ | 280 | W |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage | | $V_{GES}$ | +/-20 | V |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage | $I_C$ = 50 A, $V_{GE}$ = 15 V<br>$I_C$ = 50 A, $V_{GE}$ = 15 V<br>$I_C$ = 50 A, $V_{GE}$ = 15 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $V_{CE\,sat}$ | | 1,85<br>2,15<br>2,25 | 2,25 | V<br>V<br>V |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage | $I_C$ = 1,60 mA, $V_{CE}$ = $V_{GE}$, $T_{vj}$ = 25°C | | $V_{GEth}$ | 5,2 | 5,8 | 6,4 | V |
| Gateladung<br>Gate charge | $V_{GE}$ = -15 V ... +15 V | | $Q_G$ | | 0,38 | | µC |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor | $T_{vj}$ = 25°C | | $R_{Gint}$ | | 4,0 | | Ω |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance | f = 1 MHz, $T_{vj}$ = 25°C, $V_{CE}$ = 25 V, $V_{GE}$ = 0 V | | $C_{ies}$ | | 2,80 | | nF |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance | f = 1 MHz, $T_{vj}$ = 25°C, $V_{CE}$ = 25 V, $V_{GE}$ = 0 V | | $C_{res}$ | | 0,10 | | nF |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current | $V_{CE}$ = 1200 V, $V_{GE}$ = 0 V, $T_{vj}$ = 25°C | | $I_{CES}$ | | | 1,0 | mA |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current | $V_{CE}$ = 0 V, $V_{GE}$ = 20 V, $T_{vj}$ = 25°C | | $I_{GES}$ | | | 100 | nA |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Gon}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_{d\,on}$ | | 0,16<br>0,17<br>0,17 | | µs<br>µs<br>µs |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Gon}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_r$ | | 0,03<br>0,04<br>0,04 | | µs<br>µs<br>µs |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Goff}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_{d\,off}$ | | 0,33<br>0,43<br>0,45 | | µs<br>µs<br>µs |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Goff}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $t_f$ | | 0,08<br>0,15<br>0,17 | | µs<br>µs<br>µs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V, $L_S$ = t.b.d. nH<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Gon}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{on}$ | | 5,70<br>7,70<br>8,40 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse | $I_C$ = 50 A, $V_{CE}$ = 600 V, $L_S$ = t.b.d. nH<br>$V_{GE}$ = ±15 V<br>$R_{Goff}$ = 15 Ω | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{off}$ | | 2,80<br>4,30<br>4,80 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data | $V_{GE} \leq$ 15 V, $V_{CC}$ = 900 V<br>$V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ | $t_P \leq$ 10 µs, $T_{vj}$ = 125°C | $I_{SC}$ | | 180 | | A |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case | pro IGBT / per IGBT | | $R_{thJC}$ | | | 0,54 | K/W |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | | $R_{thCH}$ | | 0,245 | | K/W |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\,op}$ | -40 | | 150 | °C |

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper

### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj}$ = 25°C | $V_{RRM}$ | 1200 | | V |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current | | $I_F$ | 25 | | A |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current | $t_P$ = 1 ms | $I_{FRM}$ | 50 | | A |
| Grenzlastintegral<br>I²t - value | $V_R$ = 0 V, $t_P$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 125°C<br>$V_R$ = 0 V, $t_P$ = 10 ms, $T_{vj}$ = 150°C | I²t | 90,0<br>80,0 | | A²s<br>A²s |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage | $I_F$ = 25 A, $V_{GE}$ = 0 V<br>$I_F$ = 25 A, $V_{GE}$ = 0 V<br>$I_F$ = 25 A, $V_{GE}$ = 0 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $V_F$ | | 1,75<br>1,75<br>1,75 | 2,25 | V<br>V<br>V |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current | $I_F$ = 25 A, - $di_F/dt$ = 1200 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $I_{RM}$ | | 39,0<br>40,0<br>41,0 | | A<br>A<br>A |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge | $I_F$ = 25 A, - $di_F/dt$ = 1200 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $Q_r$ | | 2,40<br>4,10<br>4,40 | | µC<br>µC<br>µC |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy | $I_F$ = 25 A, - $di_F/dt$ = 1200 A/µs ($T_{vj}$=150°C)<br>$V_R$ = 600 V | $T_{vj}$ = 25°C<br>$T_{vj}$ = 125°C<br>$T_{vj}$ = 150°C | $E_{rec}$ | | 0,90<br>1,50<br>1,70 | | mJ<br>mJ<br>mJ |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | $R_{thJC}$ | | | 1,35 | K/W |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | | $R_{thCH}$ | | 0,61 | | K/W |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | | | $T_{vj\,op}$ | -40 | | 150 | °C |

## NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwiderstand<br>Rated resistance | $T_C$ = 25°C | $R_{25}$ | | 5,00 | | kΩ |
| Abweichung von R100<br>Deviation of R100 | $T_C$ = 100°C, $R_{100}$ = 493 Ω | ΔR/R | -5 | | 5 | % |
| Verlustleistung<br>Power dissipation | $T_C$ = 25°C | $P_{25}$ | | | 20,0 | mW |
| B-Wert<br>B-value | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$ | $B_{25/50}$ | | 3375 | | K |
| B-Wert<br>B-value | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$ | $B_{25/80}$ | | 3411 | | K |
| B-Wert<br>B-value | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$ | $B_{25/100}$ | | 3433 | | K |

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.



| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

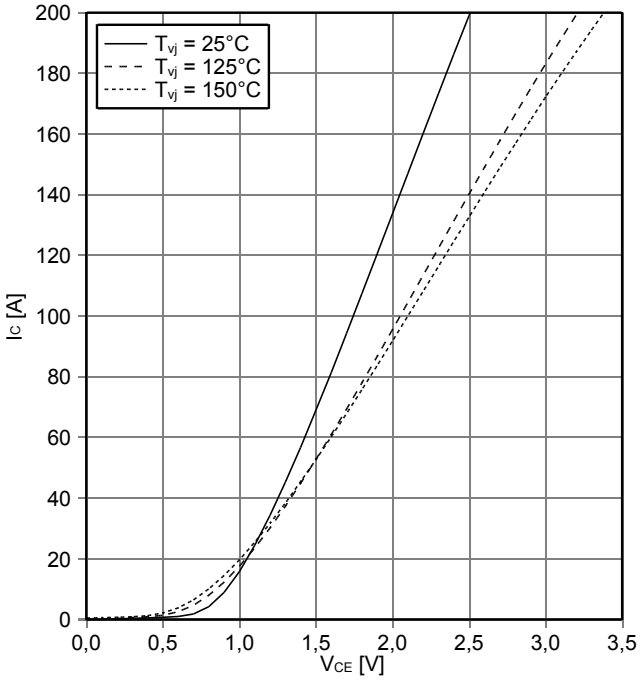
**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## Modul / Module

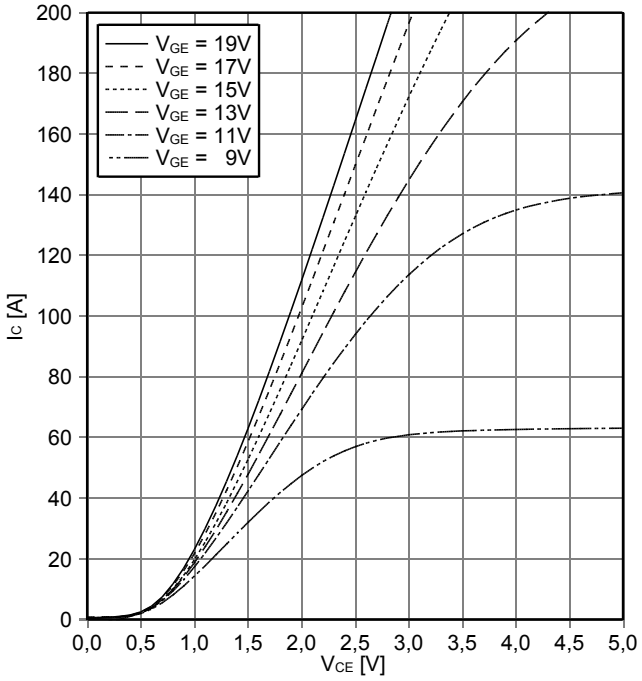
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolations-Prüfspannung<br>Isolation test voltage | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. | $V_{ISOL}$ | | 2,5 | | kV |
| Material Modulgrundplatte<br>Material of module baseplate | | | | Cu | | |
| Innere Isolation<br>Internal isolation | Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)<br>basic insulation (class 1, IEC 61140) | | | $Al_2O_3$ | | |
| Kriechstrecke<br>Creepage distance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | | 10,0 | | mm |
| Luftstrecke<br>Clearance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | | 7,5 | | mm |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung<br>Comperative tracking index | | CTI | | > 200 | | |
| | | | min. | typ. | max. | |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per module<br>$\lambda_{Paste}$ = 1 W/(m·K) / $\lambda_{grease}$ = 1 W/(m·K) | $R_{thCH}$ | | 0,009 | | K/W |
| Modulstreuinduktivität<br>Stray inductance module | | $L_{sCE}$ | | 40 | | nH |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur<br>Maximum junction temperature | Wechselrichter, Brems-Chopper / inverter, brake-chopper<br>Gleichrichter / rectifier | $T_{vj\ max}$ | | | 175<br>150 | °C<br>°C |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions | Wechselrichter, Brems-Chopper / inverter, brake-chopper<br>Gleichrichter / rectifier | $T_{vj\ op}$ | -40<br>-40 | | 150<br>150 | °C<br>°C |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature | | $T_{stg}$ | -40 | | 125 | °C |
| Anzugsdrehmoment f. Modulmontage<br>Mounting torque for modul mounting | Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M5 - Mounting according to valid application note | M | 3,00 | - | 6,00 | Nm |
| Gewicht<br>Weight | | G | | 300 | | g |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

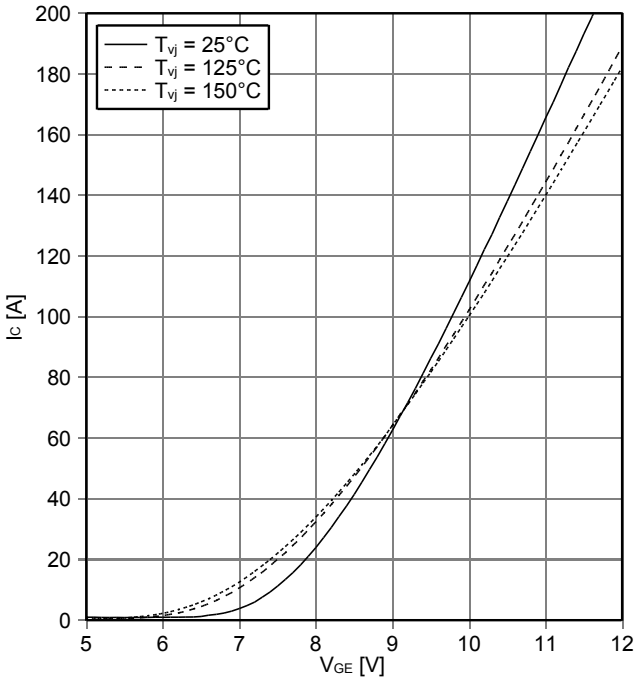
**Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)**
**output characteristic IGBT,Inverter (typical)**
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE}$ = 15 V



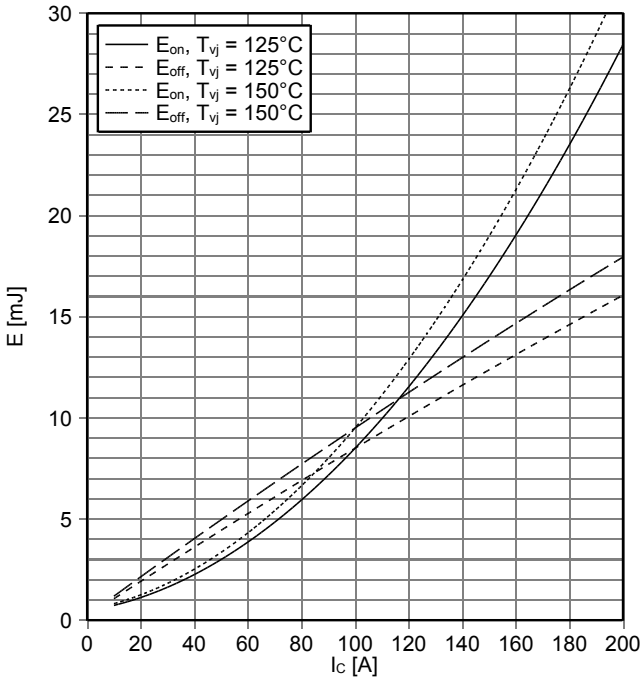

**Ausgangskennlinienfeld IGBT,Wechselrichter (typisch)**
**output characteristic IGBT,Inverter (typical)**
$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj}$ = 150°C




**Übertragungscharakteristik IGBT,Wechselrichter (typisch)**
**transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)**
$I_C = f(V_{GE})$
$V_{CE}$ = 20 V



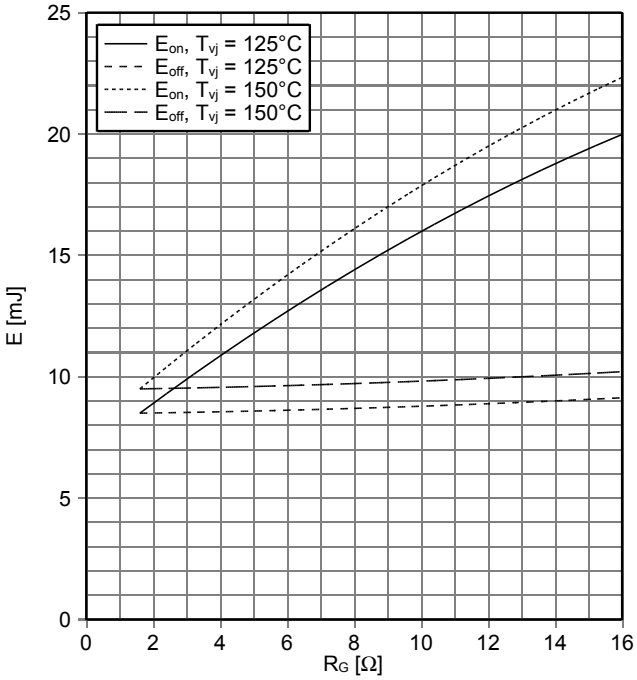

**Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)**
**switching losses IGBT,Inverter (typical)**
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
$V_{GE}$ = ±15 V, $R_{Gon}$ = 1.6 Ω, $R_{Goff}$ = 1.6 Ω, $V_{CE}$ = 600 V



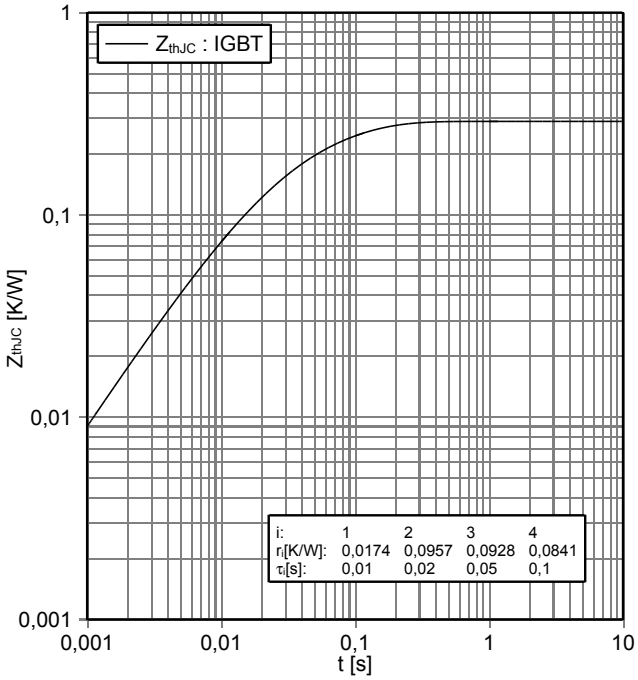

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

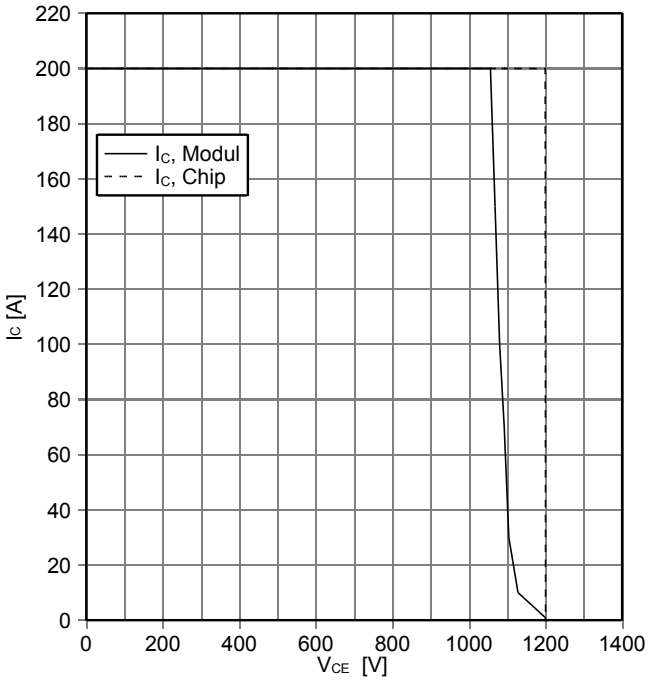
**Schaltverluste IGBT,Wechselrichter (typisch)**
**switching losses IGBT,Inverter (typical)**
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
$V_{GE}$ = ±15 V, $I_C$ = 100 A, $V_{CE}$ = 600 V



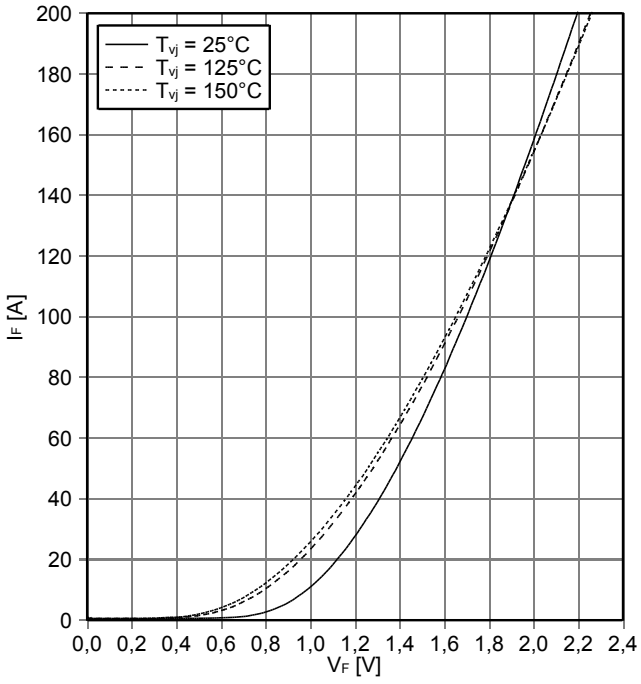

**Transienter Wärmewiderstand IGBT,Wechselrichter**
**transient thermal impedance IGBT,Inverter**
$Z_{thJC} = f(t)$




**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT,Wechselrichter (RBSOA)**
**reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)**
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE}$ = ±15 V, $R_{Goff}$ = 1.6 Ω, $T_{vj}$ = 150°C



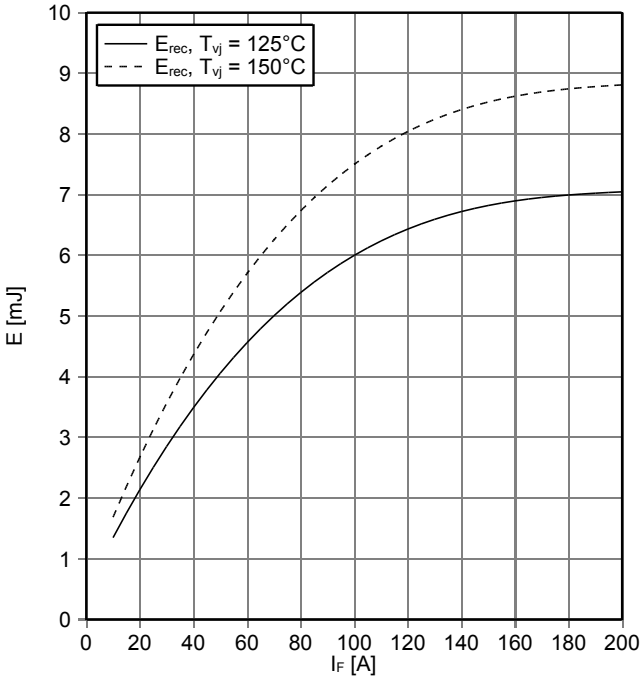

**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**
**forward characteristic of Diode, Inverter (typical)**
$I_F = f(V_F)$



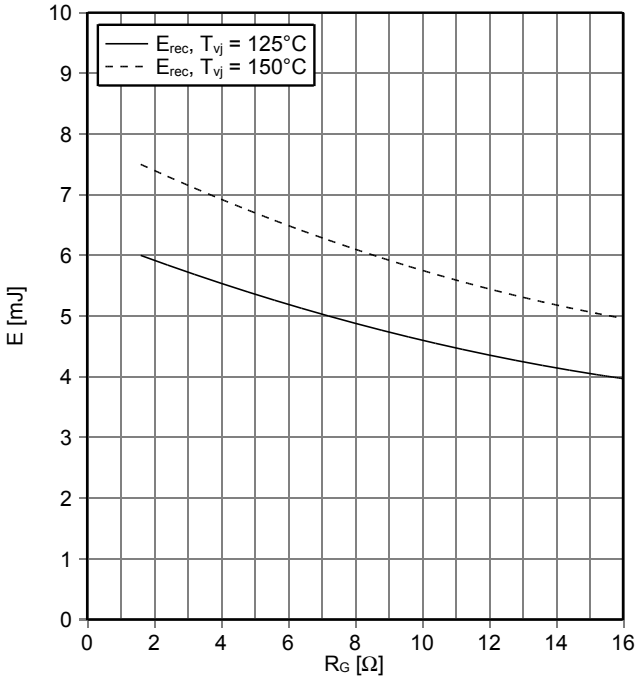

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

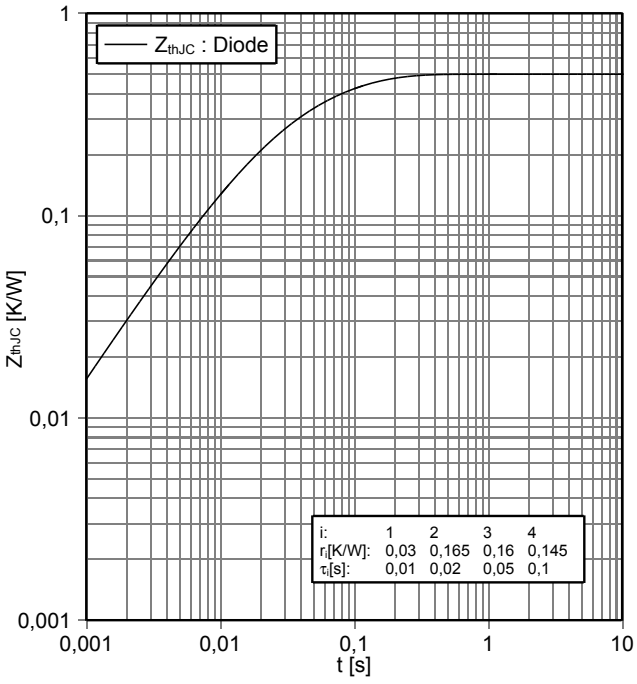
**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**
**switching losses Diode, Inverter (typical)**
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 1.6\ \Omega$, $V_{CE} = 600$ V



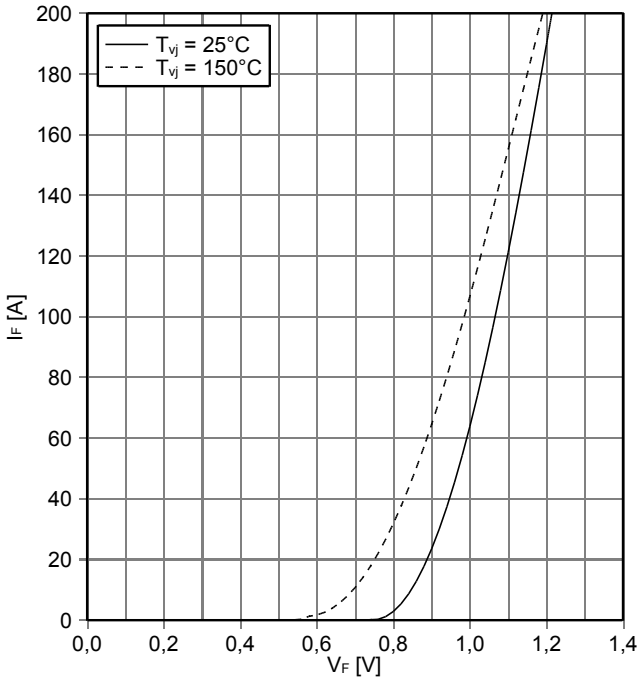

**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**
**switching losses Diode, Inverter (typical)**
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 100$ A, $V_{CE} = 600$ V




**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**
**transient thermal impedance Diode, Inverter**
$Z_{thJC} = f(t)$



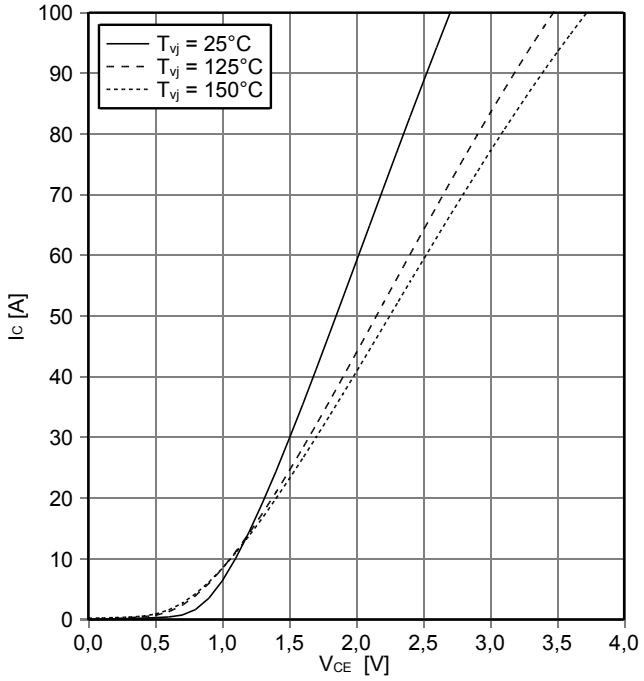

**Durchlasskennlinie der Diode, Gleichrichter (typisch)**
**forward characteristic of Diode, Rectifier (typical)**
$I_F = f(V_F)$



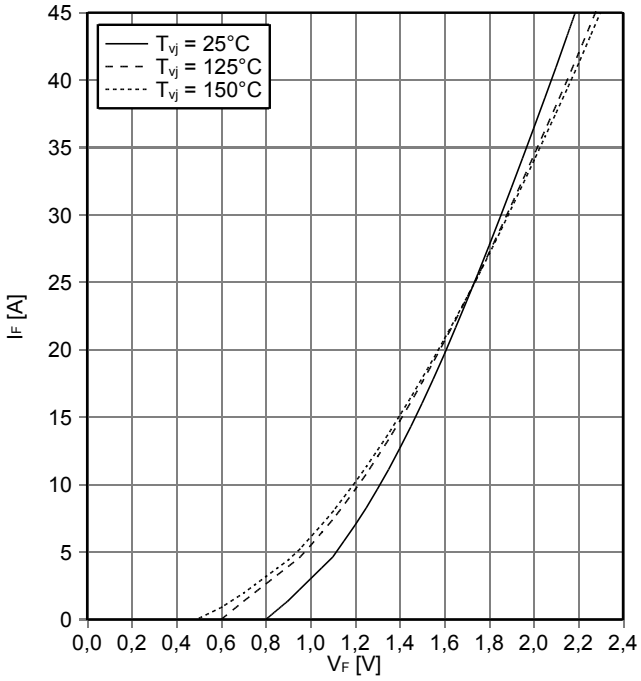

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

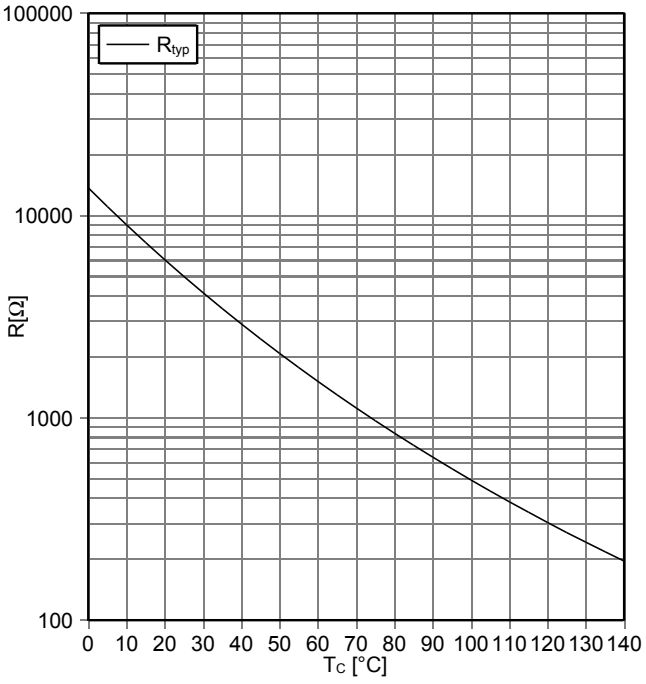
**Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)**
**output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)**
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = 15\ V$




**Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch)**
**forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)**
$I_F = f(V_F)$



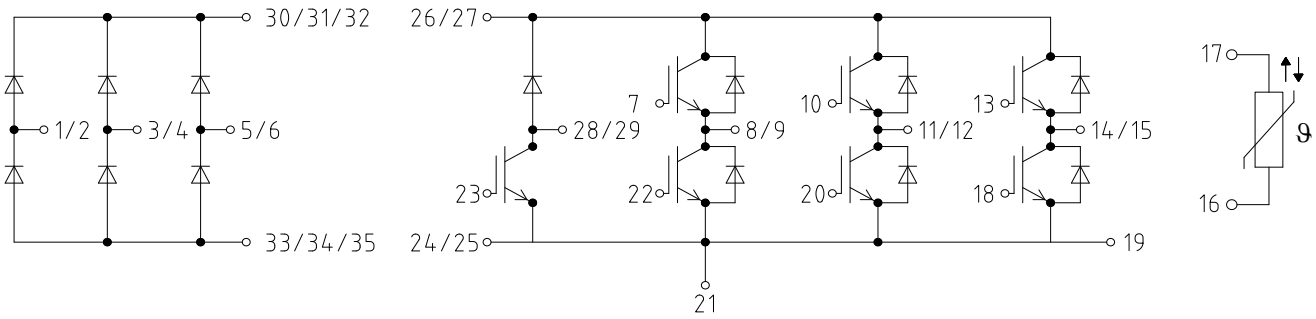

**NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)**
**NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)**
R = f (T)



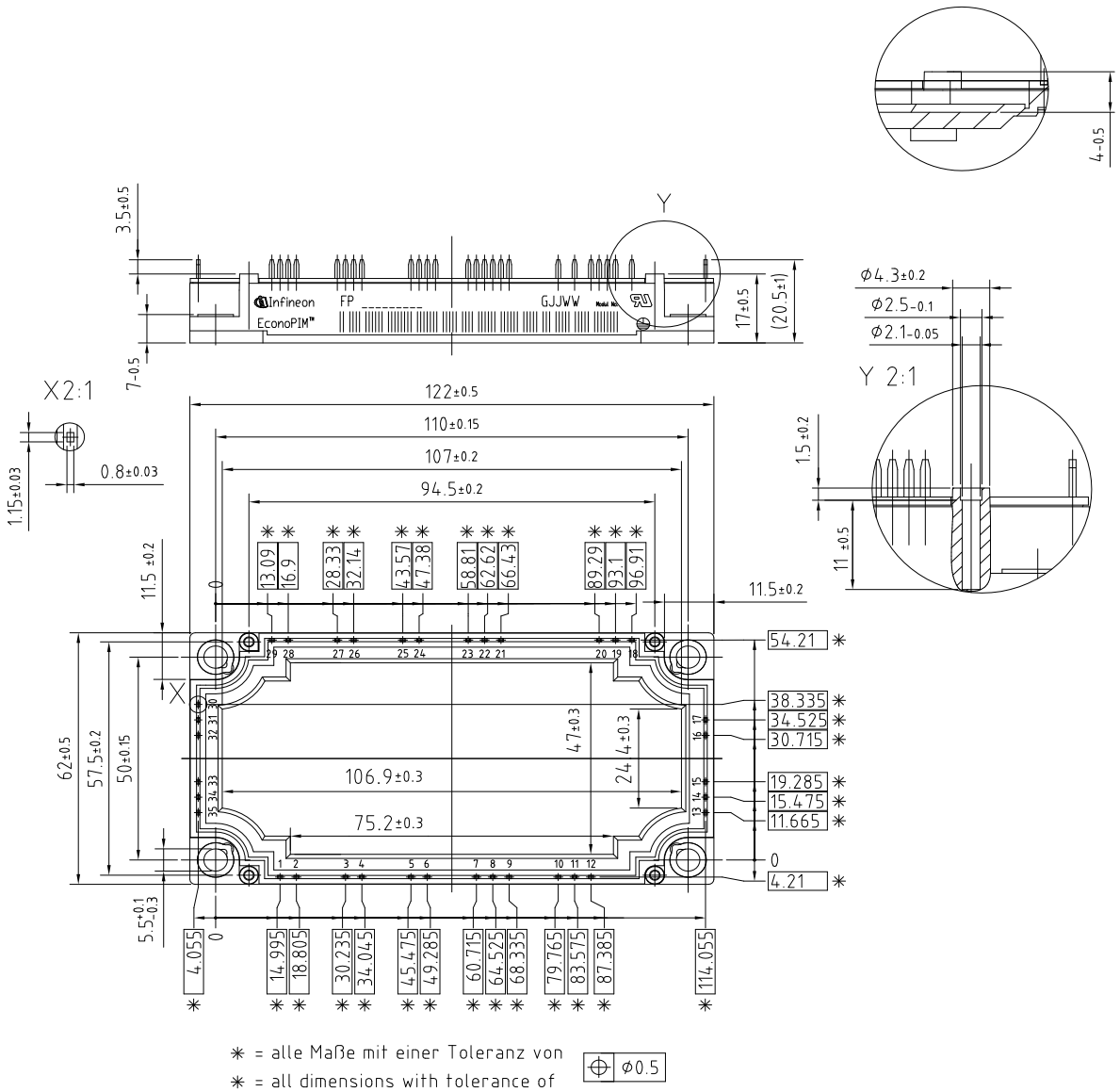

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## Schaltplan / circuit_diagram_headline




## Gehäuseabmessungen / package outlines




✳ = alle Maße mit einer Toleranz von ⌖ Φ0.5
✳ = all dimensions with tolerance of

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

**Vorläufige Daten**
**Preliminary Data**

## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see www.infineon.com ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

| | |
|---|---|
| prepared by: AS | date of publication: 2013-11-04 |
| approved by: RS | revision: 2.0 |

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9